スリットスキャン法による4 MeV光電子ビームエミッタンス測定

工藤 経生^{1,A)}、川合 啓^{A)}、黒田 隆之助^{A)}、坂上 和之^{A)}、濱 義昌^{A)}、鷲尾 方一^{A)}、柏木 茂^{B)} 早野 仁司^{C)}、浦川 順治^{C)}

^{A)} 早稲田大学理工学総合研究センター

〒169-8555 東京都新宿区大久保3-4-1

^{B)} 大阪大学産業科学研究所量子ビーム発生科学研究分野

〒567-0047 大阪府美穂ヶ丘8-1

^{C)} 高エネルギー加速器研究機構

〒305-0081 茨城県つくば市大穂1-1

概要

早稲田大学理工学総合研究センターでは、高品質 電子ビーム生成及びそれを用いた様々な応用実験を 行うことを目的として、フォトカソードRF電子銃 システムの構築を行った。高品質電子ビーム生成に は、加速器の最適パラメータを把握することが極め て重要であり、早稲田大学では、特にエミッタンス の最適値の探求を行っている。生成された光電子 ビームのエネルギーは約4MeVとあまり高くないの で、空間電荷効果の影響による測定誤差の少ない (シングル)スリット法を用いエミッタンスを測定し た。今回は新たにダブル・スリット法を取り入れ、 ソレノイド電磁石によるエミッタンス補正効果を両 方法で測定した。本研究会ではその結果及び測定法 の改善過程について報告する。

1.はじめに

現在、早稲田大学では、フォトカソードRF電子 銃から生成された電子ビームをX線発生などの応用 実験^[1]に用いることを目的として、電子ビームの高 品質化を行っている。フォトカソードRF電子銃に よって生成された電子ビームの品質は、レーザー入 射位相、ソレノイド電磁石の磁場強度、ビーム電荷 による空間電荷効果などに大きく左右され、高品質 電子ビーム生成のためには加速器の最適パラメータ を把握することが重要である。

エミッタンスの測定法としては、Qスキャン法が 広く用いられているが、早稲田大学の電子ビームの エネルギーは約4MeVとあまり高くなく、空間電荷 効果の影響が無視できなくなる。そこで、昨年度に 引き続き、空間電荷効果による測定誤差の少ないス リット・スキャン法(以下スリット法)を用いて横 方向エミッタンスの測定を行ってきた。

- 2.スリット法
- 2.1 スリット法

スリット法とは、ビームライン上に設置されたス

リットにより電子ビームを細かく切り取り、その下 流で切り取られた電子ビームのプロファイル(形 状)または電荷量を測定することにより電子ビーム の位相空間分布(エミッタンス)を求める方法であ る。スリットを1枚だけ使用し、蛍光スクリーンで ビームプロファイルを測定する方法をシングル・ス リット法、スリットを2枚使用し、ファラデーカッ プで電荷量を測定する方法をダブル・スリット法と



図1:スリット法の概念図

昨年度まではシングル・スリット法^[2]でエミッタ ンスを測定していたが、この場合、切り取られた ビームの電荷量が弱いと蛍光スクリーンが光らない といった問題や電荷量が十分な場合でもビームが蛍 光スクリーン上でにじんでしまい実際よりもビーム サイズを大きく測定し、エミッタンスを大きく算出 してしまうなどの問題点がある。そこで今回は、 ファラデーカップを用いてスリットで切り出された 電子ビームの電荷量を測定するダブル・スリット法 を取り入れた。

2.2 **ダブル・スリット**法

ダブル・スリット法を位相空間分布上で説明する。 図2の斜線部分がスリット1で切り取られた部分の 電子ビームである。スリット間がドリフトスペース だと仮定すると、スリット1で切り出された電子 ビームは、スリット2に輸送される間に位相空間上 で横に広がる。さらに、スリット2で細かく小片に 分割し、分割した小片の電荷量を測定し、それらを 総合してスリット1上での運動量方向の強度分布を 再現する。同様の事をスリット1を動かして測定す

¹ E-mail: easy-going@suou.waseda.jp

れば全体のエミッタンス(位相空間分布)が求まる。 (図2参照)



図2:ダブル・スリット法による位相空間分布

3.実験結果

3.1 セットアップ

カソードから95.5cmの位置にスリット1(厚さ 1mm)を、117.5cmの位置にスリット2(厚さ2mm) を設置した(図3参照)。スリットはタングステン でできており、スリット幅は200µm、スリットの スッテプ幅は200µmとした。



図3:セットアップ

3.2 シングル・スリット法とダブル・ス リットの比較

まず、エミッタンス補正用ソレノイド電磁石の電 流量を変えてシングル・スリット法とダブル・ス リット法によりそれぞれの場合における電子ビーム の横方向エミッタンスを測定しその比較を行った。

図4より、ソレノイド電流を変えることにより位 相空間分布(エミッタンス)を制御できることがわ かる^[3]。また、図4(C,D)は、ソレノイド電流量 を同値にして、シングル・スリット法とダブル・ス リット法で再現される位相空間分布を比較したもの である。どちらの方法で測定しても位相空間分布や エミッタンス値の変化の傾向はほぼ同様になること がわかる。エミッタンスが小さくなるときは、シン グル・スリット法とダブル・スリット法のエミッタ ンスの値の差が広がり、エミッタンスが大きくなっ ているあたりでは逆に差は縮まっている(図5参 照)。これは、エミッタンスが小さいときは電子 ビームも絞られるため、電荷密度が高くなり、蛍光 スクリーン上でのビームのにじみの効果が大きくな り、シングル・スリット法ではエミッタンスを大き く算出してしまうと考えられる。またエミッタンス

が小さいときは、電子ビームは広がっているため、 蛍光スクリーンが発光せず、シングル・スリット法 ではエミッタンスを小さく算出してしまうと考えら れる。

この実験での電子ビームの電荷量は、1バンチあたり約0.5nCであった。



図4:ソレノイド電流を変えたときの位相空間分 布(A,B,Cは100A,98A,96A(ダブル・スリット法で測 定)、Dは96A(シングル・スリット法で測定))



図5:ソレノイド電流 VS エミッタンス

3.3 レーザー入射位相とエミッタンスの関係

次に、カソード上でのレーザー入射位相を変化させ、各位相ごとにソレノイド電磁石の電流量を変えて、エミッタンスを測定した。今回は、すべてスリットのステップ幅を400µmにし、ダブル・スリット法でエミッタンスを測定した。

まず、図6にカソード上でのレーザー入射位相と ビームの電荷量・エネルギーの関係を表した。また 図7は、ソレノイド電流量を変えたときの横方向エ ミッタンスの変化を各位相ごとにプロットしたもの である。図8は、各位相ごとの横方向エミッタンス の最小値をプロットしたものである。



図6:位相と電荷量・エネルギーの関係



図7:ソレノイド電流量とエミッタンスの関係



図7より、電子ビームのエネルギーが異なると、 エミッタンスが最適値をとるソレノイド電磁石の電 流量も異なることが確認された。また、図8より、 レーザー入射位相を大きくしていくと、エミッタン スも大きくなることがわかる。これは、レーザー入 射位相を大きくしていくとショットキー効果により ビームの電荷量も大きくなり(図6参照)、空間電 荷効果の影響が大きくなることと、空洞出口でのR Fによるビーム発散の効果による影響のためと考え られる。

4.まとめと今後の予定

早稲田大学では、今年度新たにダブル・スリット 法を導入し横方向エミッタンスを測定した。今後は、 スリットのステップ幅を小さくしたり、バックグラ ウンド除去方法を工夫したりして、測定精度を上げ ていく予定である。また、電荷量を一定にしてレー ザー入射位相を変化させ、横方向エミッタンスを測 定し、RFによるエミッタンス増大の影響も測定し ていく予定である。それとともに、シングル・ス リット法でのスクリーンの滲みによる効果を消すた めに、ワイヤースキャン等の他の測定法でエミッタ ンスを測定し、ダブル・スリット法で測定されるエ ミッタンスと比較する予定である。

また、横方向エミッタンスだけでなく、RFキッ カーを用いたバンチ長の測定等、他のパラメータに ついてもその最適化を行っていく予定である。

参考文献

- S. Kashiwagi, et al., proceedings of the 27th Linear Accelerator Meeting in Japan, Kyoto, 2001, p.39
- [2] S. Kashiwagi, et al., proceedings of the 27th Linear Accelerator Meeting in Japan, Kyoto, 2001, p.353
- [3] D.T. Palmer., Proceedings of PAC, , 1997, p.2843